

GB/T 29851—2013

- c) 样品状态描述;
- d) 取样位置;
- e) 标准样品和空白样品信息;
- f) 仪器型号;
- g) 测量环境;
- h) 测量结果,包括相对灵敏度因子和杂质浓度;
- i) 操作者、测量日期、测量单位。

GB/T 29851—2013

ICS 29.045  
H 82

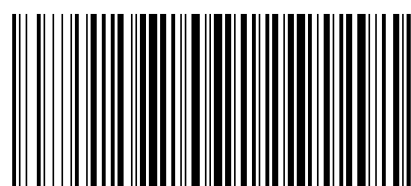


中华人民共和国国家标准

GB/T 29851—2013

## 光伏电池用硅材料中 B、Al 受主杂质 含量的二次离子质谱测量方法

Test method for measuring boron and aluminium in silicon materials used for  
photovoltaic applications by secondary ion mass spectrometry



GB/T 29851—2013

版权专有 侵权必究

\*

书号:155066·1-48021

定价: 14.00 元

2013-11-12 发布

2014-04-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

6.4.2 对中一次束,开始 SIMS 剖析。首先用第一扫描条件溅射样品 50~100 个磁场周期,直到硼和铝的信号强度稳定,以除去晶片表面自然氧化层中典型存在的残留的表面沾污。然后减小扫描面积到第二扫描条件,继续溅射样品,直到硼和铝的信号稳定。

6.4.3 剖析结束后,测试并记录电子倍增器上的<sup>11</sup>B<sup>+</sup>、<sup>27</sup>Al<sup>+</sup>的离子计数率及法拉第杯上的主元素<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>的离子计数率,对最后 20 个周期的结果进行平均。

6.4.4 重复 6.4.1~6.4.3 步骤,对样品架上所有的样品进行测试。

6.4.5 每次剖析结束后,由记录的二次离子强度,计算出<sup>11</sup>B<sup>+</sup>离子计数率和<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>离子计数率之比(<sup>11</sup>B<sup>+</sup>)/(<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>),记为 Su(B);<sup>27</sup>Al<sup>+</sup>离子计数率和<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>离子计数率之比(<sup>27</sup>Al<sup>+</sup>)/(<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>),记为 Su(Al)。

6.4.6 如果空白样品中测得的离子计数率比(<sup>11</sup>B<sup>+</sup>)/(<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>)、(<sup>27</sup>Al<sup>+</sup>)/(<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>)超过其他样品的 20%~50%,则应停止分析,寻找造成仪器背景较高的原因。

6.4.7 对所有样品,包括空白样品、标准样品和测试样品,在表格中记录样品编号和对应的离子计数率比(<sup>11</sup>B<sup>+</sup>)/(<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>)、(<sup>27</sup>Al<sup>+</sup>)/(<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>)。

## 7 结果计算

7.1 分别按式(1)和式(2)计算硼和铝的相对灵敏度因子:

$$RSF_{(B)} = \frac{[B]}{(^{11}B^+)/(^{30}Si^+)} \dots\dots\dots(1)$$

$$RSF_{(Al)} = \frac{[Al]}{(^{27}Al^+)/(^{30}Si^+)} \dots\dots\dots(2)$$

式中:

[B] ——标准样品中硼的标定浓度,单位为 atoms/cm<sup>3</sup>;

[Al] ——标准样品中铝的标定浓度,单位为 atoms/cm<sup>3</sup>;

(<sup>11</sup>B<sup>+</sup>)/(<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>) ——标准样品中<sup>11</sup>B<sup>+</sup>离子计数率和<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>离子计数率之比;

(<sup>27</sup>Al<sup>+</sup>)/(<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>) ——标准样品中<sup>27</sup>Al<sup>+</sup>离子计数率和<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>离子计数率之比。

7.2 对每个测试样品,利用测得的离子计数率比 Su 和从标准样品中得到的相对灵敏度因子 RSF,分别按照式(3)和式(4)计算测试样品中硼的浓度[B]u 和铝的浓度[Al]u。

$$[B]u = Su(B) \times RSF_{(B)} \dots\dots\dots(3)$$

$$[Al]u = Su(Al) \times RSF_{(Al)} \dots\dots\dots(4)$$

## 8 精密度

在同一实验室,由同一操作者使用同一台仪器,按照本文件对取自同一硅片的 10 个试样进行了硼和铝含量的测试。所测得的硼浓度的平均值为 9.7×10<sup>13</sup> atoms/cm<sup>3</sup>,标准偏差为 5.1×10<sup>12</sup> atoms/cm<sup>3</sup>,相对标准偏差是 5.2%;铝浓度的平均值为 8.4×10<sup>13</sup> atoms/cm<sup>3</sup>,标准偏差为 4.3×10<sup>12</sup> atoms/cm<sup>3</sup>,相对标准偏差是 5.1%。

## 9 报告

报告至少应包括以下内容:

- a) 送样单位和送样日期;
- b) 样品名称、规格和编号;

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
光伏电池用硅材料中 B、Al 受主杂质  
含量的二次离子质谱测量方法

GB/T 29851—2013

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)  
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 10 千字

2014 年 1 月第一版 2014 年 1 月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-48021 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107

### 4.3 测试样品架

要保证样品架上各样品的分析表面处于同一平面并垂直于引出电场(约几千伏,根据仪器型号的不同而不同)。

## 5 试样准备

### 5.1 标准样品

需要一个共掺杂或分别掺杂硼和铝的硅单晶标准样品,且硼和铝的体浓度经过各方都认同的其他测量方法测定,浓度在 $(1\sim 10)\times 10^{16}$  atoms/cm<sup>3</sup> 范围内,分布均匀性在 5% 以内。标准样品的分析面应进行化学腐蚀抛光或者效果更好的化学机械抛光,使其平坦光滑。

### 5.2 空白样品

需要一个硼和铝浓度均低于  $1\times 10^{12}$  atoms/cm<sup>3</sup> 的真空区熔硅单晶作为空白样品。空白样品的分析面同样应进行化学腐蚀抛光或者效果更好的化学机械抛光,使其平坦光滑。

### 5.3 测试样品

测试样品的分析面同样应进行化学腐蚀抛光或者效果更好的化学机械抛光,使其平坦光滑,且样品尺寸应适合放入样品架内。

## 6 操作步骤

### 6.1 样品装载

将样品装入二次离子质谱仪(SIMS)的样品架,并检查确认样品是否平坦地放在窗口背面,并尽可能多覆盖窗口。一次装载的样品包括:空白样品、标准样品和测试样品。

### 6.2 仪器调试

6.2.1 按照仪器说明书开启仪器,二次离子质谱仪(SIMS)应状态良好(例如经过烘烤),以尽可能降低仪器背景。

6.2.2 根据 4.2 中描述条件,如果需要使用冷却装置,则将液氮或者液氦装入冷阱。

### 6.3 分析条件

6.3.1 使用聚焦良好的氧一次离子束,调节衬度光栏和视场光栏,得到最大的<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>离子计数率。在不扫描的情况下,法拉第杯上得到的<sup>30</sup>Si<sup>+</sup>离子计数率应大于  $1\times 10^8$  counts/s。

6.3.2 调整仪器达到足够的质量分辨能力以消除质量干扰。测试铝含量时,质量分辨率( $M/\Delta M$ )应大于 1 500。

6.3.3 开始时,应根据束斑大小使用几百微米 $\times$ 几百微米的第一扫描条件(典型的条件是  $250\ \mu\text{m}\times 250\ \mu\text{m}$ ),以除去表面自然氧化层中硼、铝的干扰。实际分析时,应使用第二扫描条件,扫描区域要比第一扫描条件减少几倍(典型的第二扫描条件是  $50\ \mu\text{m}\times 50\ \mu\text{m}$ )。采用的计数时间是 1 s。

### 6.4 样品分析

6.4.1 移动样品架,使样品上的溅射坑形成在窗口的中心位置附近。

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会(SAC/TC 203)提出并归口。

本标准起草单位:信息产业专用材料质量监督检验中心、中国电子技术标准化研究院、国家电子功能与辅助材料质量监督检验中心、天津市环欧半导体材料技术有限公司。

本标准主要起草人:何友琴、马农农、王东雪、何秀坤、裴会川、冯亚彬、张雪囡。